JOURNAL OF WUXI UNIVERSITY OF LIGHT INDUSTRY

复合电沉积的 Taguchi设计

张景尧 刘松琴 郑秋容 (无锡轻工大学化学工程系,无锡 214036)

摘要将 Taguchi试验方法用于 Ni-Mo复合电沉积过程,从而筛选出最佳工艺条件,在此最佳工艺条件下所得镀层的析氢过电位 Zoo 仅为 167.3 mV. 关键词 Taguchi方法;复合镀;镍;钼

中图分类号 0 646.541

0 前 言

长期以来,为提高电极的析氢催化活性,降低电解能耗,人们作了大量的工作。Ni-Mo 镀层作为其中的一种,表现了良好的析氢催化活性,为众多研究者所关注。文献[1,2报道了 获得该镀层的方法。但不同作者采用的沉积方法不同,所得电极的析氢催化活性差异较大。 本文作者在前人工作基础上,采用 Taguchi设计方法^[3],在 Fe基电极上电沉积 Ni-Mo复合 镀层,找出最佳工艺条件,并研究了该电极的析氢催化活性

1 Taguchi方法原理

Taguchi试验方法,是 Genichi Taguchi博士于 20世纪 40年代建立的,它把一个工艺过 程的影响因素分为控制因素、显著因素和干扰因素(信号因素)。Taguchi方法,不仅关心产 品质量的标准值,还注意偏差的大小,它提出的信噪比(Signal to noise ratio)为

$$S/N = 20 \lg(X/SD)$$
 . (1)

式中X,SD分别为平均值与标准偏差

根据试验类型不同,*S*/*N*可分为 3种情况,即越大越好(LB),正常最好(NB),越小越好(SB),在 SB情况下,由于理想输出的平均值趋近于零,故方程(1)可表示为

$$S /N_{SB} = -10 \lg \left[1/n_{i=1}^{E} (1/X_{i}^{2}) \right] .$$
 (2)

根据质量特性的互反性,SB问题可转化为LB问题,其目标函数 S/N_{LB} 亦可用(2)式表示,而在正常最好问题中,理想输出值等于同一目标值,平均值期望的平方 $[E(X)]^2$ 等于

 $(S_n - S_r) / n, \text{idef} \qquad S / N_{NB} = 10 \lg \left(\frac{1}{n} \cdot \frac{(S_m - S_n)}{S_n} \right) \qquad (3)$

其中 S_m 为平均值变量, $S_m = \begin{bmatrix} E \\ i=1 \end{bmatrix}$

$$S_m = \left(\underbrace{\mathrm{E}}_{i=1} X_i \right)^2 / n \quad . \tag{4}$$

S_n为样品方差

$$S_n = \mathop{\rm E}_{i=1}^n \left(X_i - X \right)^2 / (n-1) \quad . \tag{5}$$

以上 3种问题的目标值均为一个固定的数值,通常称为静态特性。在动态情况下,理想

收稿日期: 1997-09-05

第一作者:张景尧,男,1942年3月生,讲师

?1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www

的输出(X)应为某显著因素(M)的函数

$$X = \beta M \quad . \tag{6}$$

β为相关系数,此时 Taguchi建立的目标函数为

$$S / N U = 10 \lg \left(\frac{1}{V} \cdot \frac{(S U - S_n)}{S_n} \right) \qquad (7)$$

其中 $(S_{U} = S_{n})$ N为 β 期望值的平方 $[E(U)]^{2}, S_{n}$ 为 β 的平方积

$$SU = \prod_{i=1}^{n} (M_i X_i)^2 / \prod_{i=1}^{n} M_i^2 \quad .$$
 (8)

$$V = \mathop{\mathbb{E}}_{i=1}^{n} M_{i}^{2} \quad . \tag{9}$$

2 Taguchi试验方法在电沉积过程设计中的应用

2.1 实验环节简介

实验试剂均采用分析纯,二次蒸馏水,pH值由滴加 NH[。]HO调节,Mo粉为上海试剂 站分装厂产品。镀层中的 Mo含量采用原子吸收分光光度法测定。

2.2 电化学测量

为考察电极的析氢催化活性,用 动电位扫描法测定所得电极的阴极极 化曲线,扫描速度为2mV/s,电解液 为0.1mol/L的 NaOH溶液,光亮铂 电极为辅助电极,饱和甘汞电极为参 比电极,测量前向溶液中通氮气30 min,以1mA/cm²的阴极电流恒电流 预极化30min,再测量。

2.3 Taguchi实验设计

控制因素与信号因素的水平见表 1.

根据 L₁₈ (2^{\prime} 3⁷)正交安排实验,然后测定电极的阴极极化曲线,由此算出的阴极电流 密度为 100 mA /cm²时的阴极过电位 Z₀₀对应于前述各式中的 X,以试片面积对应于 M,由 (5)(6)(7)(8)(9)式计算 S/NU.计算出的 S/NU及析氢过电位 Z₀₀ (对应于 M₁)列于表 2.

信号因素

H 沉积时间 /min

M 试片面积 /cm²

表2 正交试验表	S/Nu
----------	------

序号	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	M_1	M_2	S /NU	$Z_{100(mV)}$
1	1	1	1	3	2	1	2	2	1	2	7.07	333.5
2	1	2	1	1	1	2	1	1	1	2	4.93	281.0
3	1	3	1	2	3	3	3	3	1	2	15.43	205.4
4	1	1	2	2	1	3	1	2	1	2	10.80	330.3
5	1	2	2	3	3	1	3	1	1	2	4.24	266.4
6	1	3	2	1	2	2	2	3	1	2	2.72	305.5
7	1	1	3	1	3	3	2	1	1	2	13. 92	329.0
8	1	2	3	2	2	1	1	3	1	2	11.49	307.0
9	1	3	3	3	1	2	3	2	1	2	30.99	366.0
10	2	1	1	1	1	1	3	3	1	2	4.95	268.8
11	2	2	1	2	3	2	2	2	1	2	3. 59	190.8
12	2	3	1	3	2	3	1	1	1	2	30. 60	327.3
13	2	1	2	3	3	2	1	3	1	2	12.06	266.7
14	2	2	2	1	2	3	3	2	1	2	11. 30	367.8
15	2	3	2	2	1	1	2	1	1	2	16.34	339.4
16	2	1	3	2	2	3	3	1	1	2	29.21	354.1
17	2	2	3	3	1	2	2	3	1	2	19. 22	345.1
18	2	3	3	1	3	1	1	2	1	2	18.65	253.9

?1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www

	控制因素	水平 1	水平 2	水平 3
А	搅拌速度 /r min ⁻¹	100	200	
В	$\rm NiSO{}_4$ $\rm 6H_2O$ /g $\rm L^{-1}$	40	60	80
С	M o载荷量 /g L ^{- 1}	20	30	40
D	拧檬酸钠 /g L-1	150	200	250
Е	阴极电流密度 /m A cm ⁻²	40	80	120
F	pH值	9	10	11
G	温度 /C	30	40	50

2

水平 1

0.971

4

水平 2

2.25

6

表1 实验控制因素与信号因素的水平设置 Lug(2× 3⁷)

3.1 最佳工艺条件的选择 按表 2实验结果,可作 出各因素水平与 S /Nu的关 系,见图 1. 根据产生最低的 S /Nu (析氢过电位越低越 好),得出最佳工艺组合为 A¹, B², C², D¹, E³, F¹, G², H³.

3.2 电极的析氢催化活性

据表 2,采用 Ni-Mo复

合电 沉积法所得镀层的析氢过电位 Z_{00} 在 190. 8~ 367. 8 mV之间,比同等条件下的 Ni电 极 (Z_{00} = 483 mV)低 292 2~ 115. 2 mV.据图 2, 当采用 3. I所列最佳工艺条件 (镀液: Ni SO4 6 He O 60 g/L, 拧檬酸钠 150 g/L, Mo载荷量 30 g/L,搅拌速度 100 r/min,阴极电流密度 *Dx* 120 m A/cm², p H 9, 温度 4 $^{\circ}$ C, 沉积时间 6 min,试片面积 0. 971 cm²)时,所得的镀层的析 氢过电位 Z_{00} 仅为 167. 3 mV,比 Ni 电极低 315. 7 mV,说明用本工艺产生的 Ni-Mo复合镀层 具有良好的析氢催化活性





图 2电极的稳态极化曲线 ⊢纯镍片: 2-以最佳工艺条件所得的电极

参考文献

- 1 马 洁,初一鸣,邸 静等.Ni-Mo合金复合镀层上的析氢反应.应用化学,1997,14(1):16
- 2 林文修,陈登龙. Ni-Mo合金电沉积.化学世界, 1991, 7 294
- 3 Taguchi G. Introduction to quality engineering. Asian Productivity organization, 1986 76

Taguchi Design For Ni-Mo Co-deposited

Zhang Jingyao Liu Songqin Zheng Qiurong (Wuxi University of Light Industry Dept. of Chem. Eng. Wuxi 214036)

Abstract The optimum technology condition of Ni-Mo co-deposited has been studied by Taguchi design. For a co-deposited Ni-Mo electrode, the measured overpotential for hy-drogen evolution was 167. 3mv.

Key words taguchi design; co-deposited; nickel; molybdenum

(责任编辑:秦和平)

66